

**Список основных публикаций ведущей организации
«Научно-исследовательский институт ядерной физики
имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова» в рецензируемых научных изданиях по теме
диссертации за последние 5 лет**

1. A.P. Evseev, E.A. Vorobyeva, Yu.V. Balakshin, K.D. Kushkina, A.V. Stepanov, V.S. Chernysh, N.G. Chechenin, A.A. Shemukhin, “MWCNT-based surfaces with tunable wettability obtained by He⁺ ion irradiation”, *Surfaces and Interfaces* 23, 100955 (2021).
2. A.E. Ieshkin, A.V. Nazarov, A.A. Tatarintsev, D.S. Kireev, A.D. Zavilgelsky, A.A. Shemukhin, V.S. Chernysh, “Energy distributions of the particles sputtered by gas cluster ions. Experiment and computer simulation”, *Surface and Coatings Technology* 404, 126505 (2020).
3. A.P. Evseev, A.V. Kozhemiako, Yu.V. Kargina, Yu.V. Balakshin, E.A. Zvereva, V.S. Chernysh, M.B. Gongalsky, A.A. Shemukhin, “Radiation-induced paramagnetic defects in porous silicon under He and Ar ion irradiation”, *Radiation Physics and Chemistry* 176, 109061 (2020).
4. Киреев Д.С., Иешкин А.Е., Шемухин А.А., “Влияние температуры мишени на образование нанорельефа при облучении газовыми кластерными ионами”, *Письма в "Журнал технической физики"* 46 (9), 3-6 (2020).
5. A.V. Kozhemiako, A.P. Evseev, Yu.V. Balakshin, A.A. Shemukhin, “Features of defect formation in nanostructured silicon under ion irradiation”, *Semiconductors* 53, 800–805 (2019).
6. Yu.V. Balakshin, A.V. Kozhemiako, S. Petrovic, M. Erich, A.A. Shemukhin, V.S. Chernysh, “Influence of the Charge State of Xenon Ions on the Depth Distribution Profile Upon Implantation into Silicon”, *Semiconductors* 53, 1011–1017 (2019)
7. A.A. Shemukhin, A.V. Nazarov, A.V. Stepanov, “LAMMPS Code Simulation of the Defect Formation Induced by Ion Incidence in Carbon Nanotubes”, *Supercomputing Frontiers and Innovations* 6 (1), 9-13 (2019).